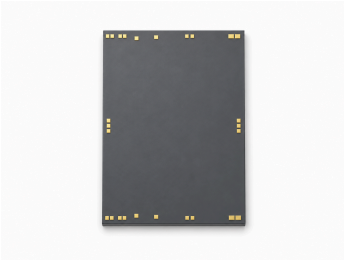


12200–16000 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

PSAT: 46 dBm (Minimum) / 46.5 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (Minimum) / 19.5 dB (typisch); PAE: 33 % (typisch). Chipabmessungen: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsfrequenz	f	12200	-	16000	12200–16000	MHz
Sättigungsausgangsleistung	Psat	46	46.5	-	-	dBm
Leistungsverstärkung	Gp	19	19.5	-	-	dB
Welligkeit der Leistungsverstärkung	ΔGp	-	-	±0.5	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	PAE	-	33	-	-	%
Eingangs-VSWR	VSWR(in)	-	1.6	2	-	-

DC-Bias und Strom · TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Drainspannung	Vd	-	28	32	V
Gatespannung	Vg	-3.2	-3	-2.8	V
Drain-Ruhestrom	Id	-	0.3	-	A
Dynamischer Drainstrom	Idd	-	5	5.5	A
Dynamischer Gatestrom	Igg	-	3	10	mA

Grenzwerte

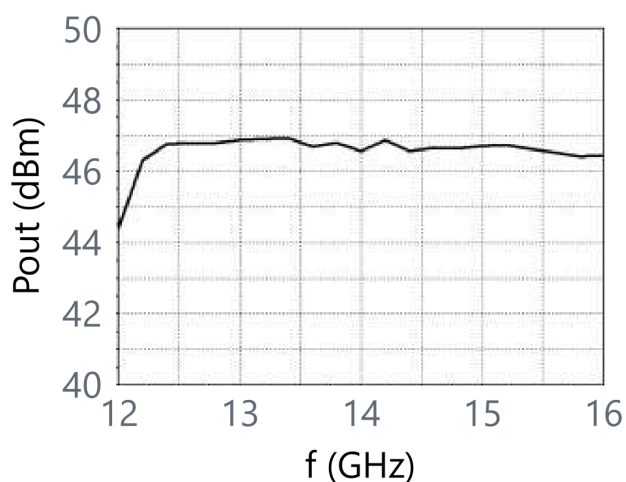
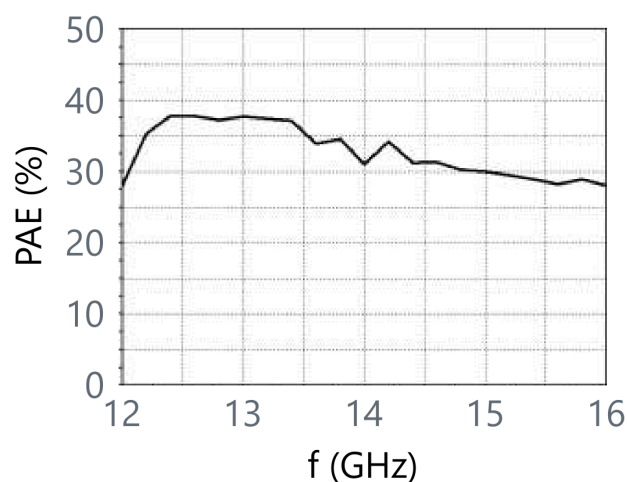
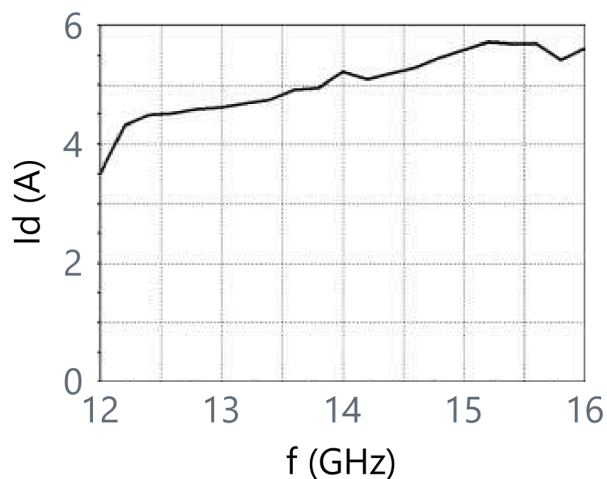
Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	Vd	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	Vg	-5	-	-	V
Maximale Eingangsleistung	Pin	-	-	30	dBm
Lagertemperatur	TSTG	-65	-	150	°C
Maximale Kanaltemperatur	Top	-	-	225	°C

Kennlinien

Diagramme aus dem ursprünglichen Datenblatt. Beachten Sie die bei jeder Abbildung angegebenen Betriebsbedingungen.

Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom.

Angabe auf der Quellseite: $V_d = +28V$; $V_g = -3.0V$. Die dargestellten Original-Diagrammflächen samt Kurven und Raster bleiben erhalten; nur äußere Achsen und Anordnung sind neu gesetzt. Messdatenreihen oder verdeckte Zustände werden nicht rekonstruiert. $P_{in} = 27 \text{ dBm}$. Die Bedingungen gelten für die angegebenen Teilbilder und deren jeweilige Legenden.



[Quelle](#)

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.